



一种总剂量效应与工艺波动耦合的电路仿真方法



郑齐文; 崔江维⁺; 李小龙; 魏莹; 余学峰⁺; 李豫东⁺; 郭旗⁺



2022-08-30

专利权人

中国科学院新疆理化技术研究所

授权日期

2022-08-30

专利类型

发明专利

摘要

本发明涉及一种总剂量效应与工艺波动耦合的电路仿真方法,该方法包括总剂量效应关联工艺参数确定、晶体管总剂量辐照试验、晶体管电参数退化方程参数提取、不同工艺角晶体管总剂量效应模型生成、不同工艺角电路仿真。该方法的理论基础是晶体总剂量辐射损伤与工艺波动参数相关,总剂量辐射效应与工艺波动存在耦合效应。该方法的优势在于考虑总剂量效应与工艺波动耦合,准确仿真辐射环境工作集成电路特性。

申请日期

2020-10-20

申请号

CN202011125363.X

公开(公告)号

112214952B

代理机构

乌鲁木齐中科新兴专利事务所(普通合伙) 65106

文献类型

专利

条目标识符

http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/8708

专题

固体辐射物理研究室

推荐引用方式

郑齐文,崔江维,李小龙,等. 一种总剂量效应与工艺波动耦合的电路仿真方法. 112214952B[P]. 2022-08-30.

GB/T 7714



条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目



保存到收藏夹



查看访问统计



导出为Endnote文件

谷歌学术



谷歌学术中相似的文章



[郑齐文]的文章



[崔江维]的文章



[李小龙]的文章

百度学术



百度学术中相似的文章



[郑齐文]的文章



[崔江维]的文章



[李小龙]的文章

必应学术



必应学术中相似的文章



[郑齐文]的文章



[崔江维]的文章



[李小龙]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

